

2SB1007

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

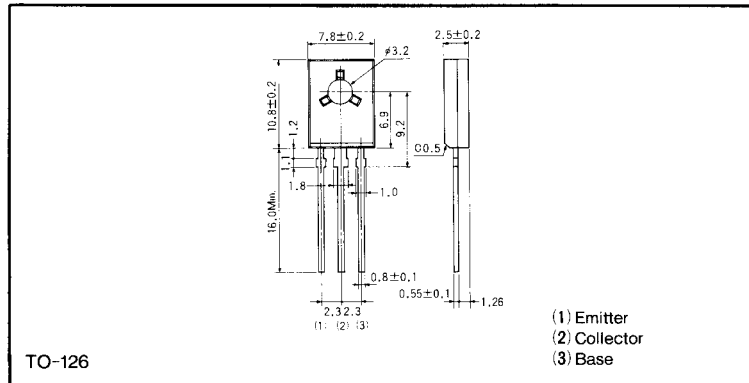
● 特長

- 1) $V_{CEO} = -80V$ の高耐圧である。
- 2) 2SD1378 とコンプリである。

● Features

- 1) High breakdown voltage:
 $V_{CEO} = -80V$
- 2) Complementary pair with 2SD1378.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-700	mA
コレクタ損失	P_C	10	W ($T_c = 25^\circ C$)
		1.2	W ($T_a = 25^\circ C$)
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-80	—	—	V	$I_C = -2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-80	—	—	V	$I_C = -50 \mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	—	—	V	$I_E = -50 \mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{CB} = -50V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB} = -4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	-0.2	-0.4	V	$I_C/I_E = -500mA/-50mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C = -3V/-100mA$
利得帯域幅積	f_T	—	100	—	MHz	$V_{CE} = -10V, I_E = 50mA$
出力容量	C_{ob}	—	14	20	pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記号	
2SB1007	PQR	基本発注単位(個)	1 000
			◎